01;05.4;11

Поверхностное сопротивление сверхпроводников II рода: влияние поверхностного барьера

© Н.В. Железина, Г.М. Максимова

Нижегородский государственный университет E-mail: maksimova@phys.unn.runnet.ru

Поступило в Редакцию 16 ноября 2000 г.

Рассчитана величина поверхностного импеданса сверхпроводящей пластины, находящейся в смешанном состоянии. В том случае, когда постоянное магнитное поле перпендикулярно поверхности пластины, реальная часть импеданса как функция магнитного поля имеет максимум, что является проявлением размерного эффекта. Исследовано поведение этого максимума в зависимости от толщины пластины и от частоты переменного поля. При переходе к параллельной геометрии учет барьера Бина—Ливингстона приводит к образованию безвихревых областей вблизи поверхностей пластины, следствием чего является уменьшение поверхностного сопротивления и подавление размерного эффекта.

Поверхностный импеданс является одной из важнейших характеристик, позволяющих изучать электродинамический отклик сверхпроводников в смешанном состоянии. Так, линейный отклик на переменное поле сверхпроводника второго рода, учитывающий эффекты нелокального вихревого взаимодействия, пиннинга и крипа магнитного потока, был рассмотрен в работах [1-3]. В [4] была сформулирована нелокальная модель критического состояния для описания поведения в переменном поле жестких сверхпроводников с размерами порядка лондоновской длины λ . Авторами работы [5] было показано, что для образцов с ровными краями существование барьера Бина—Ливингстона, регулирующего процессы входа (или выхода) вихрей, приводит к значительному уменьшению диссипативных потерь.

В данной работе теоретически исследовано поведение поверхностного сопротивления сверхпроводящей пластины конечной толщины в слабом переменном поле при различной ориентации (перпендикулярной и параллельной) постоянного магнитного поля с учетом барьера Бина—

Ливингстона. В том случае, когда барьер Бина—Ливингстона препятствует проникновению вихрей через поверхность образца и число вихрей в пластине остается фиксированным, поверхностное сопротивление существенно уменьшается и изменяется его зависимость от величины постоянного магнитного поля.

1. Поперечная геометрия. Рассмотрим сверхпроводящую пластину толщиной d ($0 \leqslant x \leqslant d$) без объемного пиннинга, находящуюся в постоянном перпендикулярном магнитном поле H_0 , создающем в образце вихревую решетку с плотностью $n_0 = H_0/\Phi_0$, где Φ_0 — квант магнитного потока. Переменное магнитное поле малой амплитуды с частотой ω параллельно плоскости пластины. Система уравнений для определения магнитного поля $\mathbf{h}(x,t) = \mathbf{h}(x) \exp(-i\omega t)$ внутри пластины имеет вид:

$$\mathbf{h} - \lambda^2 \frac{\partial^2 \mathbf{h}}{\partial x^2} = H_0 \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x},\tag{1}$$

$$\eta \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{1}{c} \left[\mathbf{j} \mathbf{\Phi}_0 \right] + \frac{\Phi_0}{H_0} C_{44}^* \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial x^2}, \tag{2}$$

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \operatorname{rot} \mathbf{h}. \tag{3}$$

Здесь $\mathbf{u}(x,t)=\mathbf{u}(x)\exp(-i\omega t)$ — вектор смещения вихревой линии, $\eta=\Phi_0H_{c2}/c^2\rho_n$ — коэффициент вязкости, c — скорость света, ρ_n — удельное сопротивление в нормальном состоянии, C_{44}^* — локальный модуль изгиба вихревой решетки [6]:

$$C_{44}^* = \frac{\Phi_0 H_0}{16\pi^2 \lambda^2} \ln \frac{a}{\xi},\tag{4}$$

где a — межвихревое расстояние, ξ — радиус кора вихря. Поиск решений (1)–(3) в виде $u(x,t) \propto h(x,t) \propto \exp(kx-i\omega t)$ приводит к дисперсионному уравнению для $k=k(\omega)$. В области частот $\omega \ll \omega_c$ его решения, соответствующие длинноволновой (k_1) и коротковолновой (k_2) модам, определяются формулами

$$k_1^2 = -\frac{i\omega}{\lambda^2(\omega_c + \omega_b)}, \qquad k_2^2 = \frac{1}{\lambda^2} \left(1 + \frac{\omega_b}{\omega_c} \right),$$
 (5)

где

$$\omega_c = \frac{\Phi_0 C_{44}^*}{H_0 \lambda^2 \eta}, \qquad \omega_b = \frac{\Phi_0 H_0}{4\pi \lambda^2 \eta}.$$
 (6)

Отметим, что впервые модель двухмодовой электродинамики для сверхпроводников II рода в смешанном состоянии была сформулирована в [6]. Решение уравнений (1)–(3) с учетом (4)–(6) позволяет найти поверхностный импеданс пластины в поперечном магнитном поле

$$Z = \frac{4\pi}{c} \frac{E(0)}{h(0)},\tag{7}$$

где E(0) — электрическое поле на поверхности пластины. Если поверхностный пиннинг отсутствует и концы вихревых нитей могут свободно перемещаться вдоль поверхностей пластины, то

$$Z = \frac{4\pi i\omega}{\lambda^2 c^2} \left(\frac{(1-\lambda^2 k_2^2)}{k_1} \tanh \frac{k_1 d}{2} - \frac{(1-\lambda^2 k_1^2)}{k_2} \tanh \frac{k_2 d}{2} \right) \cdot (k_2^2 - k_1^2)^{-1}.$$
 (8)

Для достаточно толстых пластин $d \geqslant k_1^{-1}$ получим отсюда:

$$Z = -\frac{4\pi i\omega}{c^2 k_1} \,\mu \tanh \frac{k_1 d}{2},\tag{9}$$

где $\mu=\omega_b/(\omega_c+\omega_b)$. Как следует из (9), величина $\text{Re}Z=\rho_s(H_0,\omega)$ является немонотонной функцией H_0 и достигает максимума при $H_0=H_0^*$, когда характерная глубина проникновения переменного поля становится порядка толщины образца: $k_1^{-1}(H_0^*)\propto d$. Данный размерный эффект аналогичен эффекту Фишера–Као для нормальных металлов [7], а также хорошо известен для жестких сверхпроводников (см., например, [4]). Максимальное значение поверхностного сопротивления $R=\rho_{s_{\max}}/\chi_n$ ($\chi_n=2\pi\omega d/c^2$ — величина поверхностного реактанса в нормальном состоянии) зависит от толщины пластины d/λ и от частоты переменного поля. С увеличением d/λ R стремится к постоянному значению, не зависящему от параметров сверхпроводника и частоты ω (рис. 1). Заметим, что аналогичное поведение R дает и нелокальная модель критического состояния для жестких сверхпроводников [4], но предельное значение R здесь примерно в два раза меньше.

2. Параллельная геометрия. В случае, когда постоянное магнитное поле параллельно пластине, взаимодействие вихрей с поверхностью приводит к появлению барьера Бина—Ливингстона, препятствующему входу (и выходу) вихрей в образец. При этом при определенном значении магнитного поля H_0 вихри в пластине занимают центральную

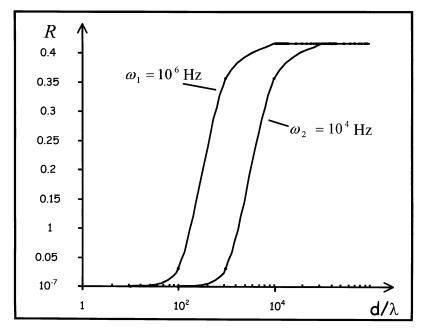


Рис. 1. Зависимость высоты максимума поверхностного сопротивления $R=
ho_{s_{
m max}}/\chi_n(\chi_n=2\pi\omega d/c^2)$ от толщины пластины.

ее часть $d/2 - a \le x \le d/2 + a$, ширина которой, равная 2a, зависит от H_0 и величины захваченного магнитного потока Φ :

$$\Phi = \frac{2aH_0}{\cosh(d/2 - a)/\lambda}. (10)$$

При данной величине Φ магнитное поле в (10) может меняться в интервале $H_{ex} \leqslant H_0 \leqslant H_{en}$, где H_{ex} , H_{en} — поля, при которых исчезает барьер на выход и вход вихрей соответственно. Таким образом, вблизи поверхности пластины образуются безвихревые области, в которых протекают мейсснеровские токи. Наложение слабого параллельного переменного магнитного поля приводит к колебаниям вихревой области при сохранении магнитного потока Φ . Решая электродинамическую

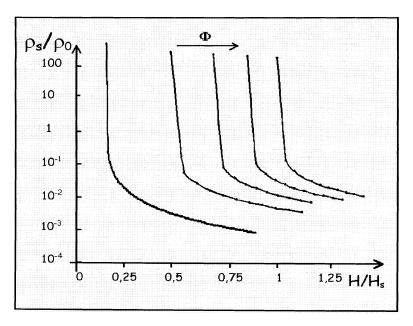


Рис. 2. Поверхностное сопротивление пластины в параллельном магнитном поле (с учетом барьера Бина–Ливингстона) при различной величине захваченного магнитного потока $\Phi(\rho_0=4\pi\omega_0\lambda/c^2,\ \omega_0=1\,\mathrm{Hz})$. Стрелкой указано направление возрастания магнитного потока.

задачу в этом случае, получим для Z выражение:

$$Z = -\frac{4\pi i\omega\lambda}{c^2} \frac{\alpha \tanh\frac{a}{\alpha} + \lambda \tanh b}{\lambda + \alpha \tanh\frac{a}{\alpha} \tanh b},$$
 (11)

где $b=(d/2-a)/\lambda$ — относительная ширина безвихревых областей, $\alpha=\lambda(1+il^2/\lambda^2/\cosh b)^{1/2},\ l=(\Phi_0H_0/4\pi\eta\omega)^{1/2}.$ Как следует из (11), в случае b=0 (т.е. в отсутствии безвихревых областей) поверхностный импеданс для плотной вихревой решетки ($\mu\approx 1$) совпадает с соответствующим выражением (9) для перпендикулярной геометрии. Рассмотренная ситуация, по-видимому, возникает в случае, когда поверхности пластин являются шероховатыми, в результате чего барьер Бина–Ливингстона сильно подавлен. Если же область, занятая вихрями,

отделена от поверхностей пластины $(b \neq 0)$, то, как показывают расчеты, поверхностное сопротивление, во-первых, значительно уменьшается. Узкая безвихревая область $\lambda/l \ll b < 1$ приводит к подавлению вязких потерь примерно в $(b \cdot l/\lambda^2)^2$ раз. Для типичных ВТСП материалов, как показывают расчеты, поверхностное сопротивление, во-первых, значительно уменьшается. Узкая безвихревая область $\lambda/l \ll b < 1$ приводит к подавлению вязких потерь примерно в $(b \cdot l/\lambda^2)^2$ раз. Для типичных ВТСП материалов с $\lambda \approx 1300\,\text{Å},\,H_{c2} = \Phi_0/(2\pi\xi^2) \propto 300\,T$ при $H_0 \propto 0.01 H_{c2}$ и $\omega \propto 10^6$ Hz значение $(b \cdot l/\lambda^2)^2 \propto 10^3$. Во-вторых, изменяется зависимость $\rho_s(H_0)$ — поверхностное сопротивление в рассматриваемом случае является убывающей функцией постоянного магнитного поля H_0 во всем интервале $H_{ex} \leqslant H_0 \leqslant H_{en}$, соответствующем сохраняющемуся магнитному потоку (рис. 2). Таким образом, если в этом интервале полей существовал максимум функции $\rho_s(H_0)$, то наличие безвихревых областей вблизи поверхности пластины $(b \neq 0)$ приводит к его исчезновению, т.е. к подавлению размерного эффекта.

Авторы признательны И.Л. Максимову и Д.Ю. Водолазову за интерес к работе и полезные обсуждения.

Работа поддержана Миннауки РФ (проект 107-1~(00)), а также Международным центром перспективных исследований (г. Н. Новгород; грант 99-02-3).

Список литературы

- [1] Coffev M.W., Clem J.R. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 67. P. 386–389.
- [2] Clem J.R., Coffey M.W. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. P. 14662-14674.
- [3] Coffey M.W., Clem J.R. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. P. 11757-11764.
- [4] Fisher L.M. et al. // Physica C. 1995. V. 245. P. 231-237.
- [5] Sonin E.B., Traito K.B. // Phys. Rev. B. 1994. V. 50. P. 13547-13556.
- [6] Sonin E.B., Tagantsev A.K., Traito K.B. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. P. 5830–5832.
- [7] Fischer H., Kao Y.-H. // Sol. St. Comm. 1969. V. 7. P. 275–277.